



SEL-369: Micro-ondas

Prof. Amílcar Careli César

Lista número **5**

Data

Nome

Número USP

Os parâmetros S de um transistor em 4 GHz e em sistema de 50 ohms são dados na tabela abaixo:

Transistor FET de GaAs		
Parâmetro S	Módulo	Fase (graus)
S_{11}	0,6	-60
S_{12}	0,0	0
S_{21}	2,0	81
S_{22}	0,7	-60
Parâmetros de ruído		
F_{min}	2,0	dB
Γ_{ot}	0,62	100
R_N	20	ohms

Projetar um amplificador com ganho transdutivo 6 dB e a menor figura de ruído possível para este ganho. Ao projetar os circuitos de casamento de impedâncias, utilizar o esquema padrão, com linha em série e toco em aberto.